

## ЧАСТОТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДИССИПАЦИИ В СМЕШАННОМ СОСТОЯНИИ ЧИСТЫХ СВЕРХПРОВОДНИКОВ ВТОРОГО РОДА ПРИ НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ

Н.Б.Копнин

Диссипативная часть тензора проводимости в предельно чистых сверхпроводниках при низких температурах имеет пик на частоте  $\omega \sim \Delta^2/E_F$ , обусловленный наличием связанных состояний в остовах вихрей.

Чистые сверхпроводники второго рода в смешанном состоянии обладают рядом интересных особенностей. Так, проводимость и угол Холла в постоянном электрическом поле при низких температурах  $T \ll \Delta$  существенным образом зависят от времени свободного пробега электронов по отношению к столкновениям с примесями в области  $\tau \sim E_F/T_c^2$ , т.е. в той области, где согласно критерию Андерсона сверхпроводник должен считаться чистым:  $\tau \Delta \gg 1$ . Как было показано в работе [1], в магнитных полях  $H \ll H_{c2}$  переход к бездиссипативному движению вихрей (увлечение вихрей натекающим сверхтекучим потоком) происходит при  $\tau \Delta^2/E_F \gg 1$ , в то время как при  $\tau \Delta^2/E_F \ll 1$  движение вихрей сохраняет диссипативный характер. Эти свойства чистых сверхпроводников обусловлены наличием связанных состояний в остовах вихрей [2]. Низколежащие связанные состояния  $\zeta_\nu(k)$  характеризуются азимутальным квантовым числом  $\nu$  и импульсом  $k$  вдоль оси вихря. По азимутальному числу эти уровни образуют эквидистантный дискретный спектр с расстоянием между уровнями  $\partial \zeta_\nu(k)/\partial \nu \sim \Delta^2/E_F$ . Соотношение между временем пробега  $\tau$  и расстоянием между уровнями определяет указанные выше особенности движения вихрей.

Представляется довольно очевидным, что наличие связанных состояний должно также сильно сказываться на поглощении высокочастотного электромагнитного поля в области частот  $\omega \sim \Delta^2/E_F \sim 10^8 - 10^9 \text{ сек}^{-1}$ . Эти эффекты должны наиболее отчетливо проявляться в предельно чистом случае  $\tau \Delta^2/E_F \gg 1$ . Изучению таких особенностей и посвящена настоящая работа.

Ниже мы будем рассматривать случай низких температур  $T \ll \Delta$  и считать для простоты, что параметр Гинзбурга - Ландау  $\kappa \gg 1$ , а магнитное поле удовлетворяет условию  $H_{c1} < H \ll H_{c2}$ .

Существование электрического поля в массиве сверхпроводника объяснено электромагнитной индукцией, возникающей при движении вихревых нитей:

$$\mathbf{E} = -i\omega c^{-1} B[\mathbf{n}_H, \mathbf{u}], \quad (1)$$

где  $B$  - магнитная индукция,  $\mathbf{n}_H$  - единичный вектор в направлении  $\mathbf{B}$ , а  $\mathbf{u}$  - смещение вихревых нитей. Связь между током и смещением вих-

рей находится согласно [1] из соотношения

$$\frac{\pi}{e} [j_{tr}, n_H] = \nu(0) \int \frac{\partial \epsilon}{4} d^2 r \text{Sp} \{ \hat{g}^{(a)} \nabla \hat{H} \}, \quad (2)$$

где 
$$\hat{H} = \begin{pmatrix} 0 & -\Delta \\ \Delta^* & 0 \end{pmatrix},$$

а матричная функция Грина  $\hat{g}^{(a)}$  при  $r \Delta^2 / E_F \gg 1$  определяется уравнением

$$\hat{g}^{(a)}(r) = \frac{1}{\pi i \nu(0)} \int d^3 r_1 \hat{G}_\epsilon^R(r, r_1) \frac{\omega u}{2T} \nabla \hat{H} \text{ch}^{-2}\left(\frac{\epsilon}{2T}\right) \hat{G}_{\epsilon-\omega}^A(r_1, r), \quad (3)$$

Выражения для функций  $\hat{G}_\epsilon^{R(A)}$  были получены в [1]. Полусная часть функций  $\hat{G}_\epsilon^{R(A)}$  представляет собой разложение по собственным функциям связанных состояний. При суммировании по  $\nu$  основной вклад в (2) дает обход полюсов, соответствующих связанным состояниям. В результате получаем

$$j_{tr i} = \sigma_{ik}(\omega) E_k, \quad (4)$$

где тензор проводимости

$$\sigma_{ik}(\omega) = \sigma^{(O)}(\omega) \delta_{ik} + \delta^{(H)}(\omega) e_{ikl} (n_H)_l$$

имеет вид

$$\sigma^{(O)}(\omega) = -i \frac{ce}{B} \frac{P_F}{-P_F} \int \frac{dk}{(2\pi)^2} q^2 \frac{\partial \epsilon_\nu(k)}{\partial \nu} \frac{\omega + \frac{i}{\tau_k}}{\left(\frac{\partial \epsilon_\nu}{\partial \nu}\right)^2 - \left(\omega + \frac{i}{\tau_k}\right)^2}, \quad (5)$$

$$\sigma^{(H)}(\omega) = \frac{ce}{B} \frac{P_F}{-P_F} \int \frac{dk}{(2\pi)^2} q^2 \left(\frac{\partial \epsilon_\nu(k)}{\partial \nu}\right)^2 \frac{1}{\left(\frac{\partial \epsilon_\nu}{\partial \nu}\right)^2 - \left(\omega + \frac{i}{\tau_k}\right)^2} \quad (6)$$

Здесь  $\epsilon_\nu(k)$  – энергия связанных состояний [2]:

$$\epsilon_\nu(k) = \int_0^\infty \frac{\nu |\Delta|}{q\rho} e^{-2K} d\rho / \int_0^\infty e^{-2K} d\rho,$$

а

$$\tau_k^{-1} = \frac{1}{2\tau} \int_0^{\infty} (g^R - g^A) e^{-2K\rho} d\rho / \int_0^{\infty} e^{-2K\rho} d\rho,$$

$$K = \int_0^{\rho} \frac{m |\Delta|}{q} d\rho, \quad q = (p_F^2 - K^2)^{1/2}.$$

Выражения (5), (6) верны в пределе  $\tau \Delta^2/E_F \gg 1$ , они, однако, качественно описывают ситуацию и в случае  $\tau \Delta^2/E_F \sim 1$ . Из выражения (5) видно, что вещественная часть  $\text{Re } \sigma^{(0)}(\omega)$ , определяющая диссипацию, при  $\tau \Delta^2/E_F \sim 1$  имеет, вообще говоря, пик на частоте  $\omega \sim \Delta^2/E_F$ . Точное выражение для  $\sigma_{ik}(\omega)$  при  $\tau \Delta^2/E_F \sim 1$  можно получить, определяя  $\hat{g}^{(a)}$  из полного кинетического уравнения. Аналитическое решение кинетического уравнения возможно, однако, лишь при определенных упрощающих предположениях относительно вида потенциала  $|\Delta(\rho)|$  (см. например [1]).

Для предельно чистых сверхпроводников  $\tau \Delta^2/E_F \gg 1$  проводимость сильно зависит от соотношения между  $\omega$  и  $\partial \epsilon_{\nu}(k)/\partial \nu$ . При  $\omega \ll \partial \epsilon_{\nu}(k)/\partial \nu$  уравнение (4) с учетом (1) принимает вид

$$\frac{\pi}{e} \left[ (j_{ir} - Ne \frac{\partial u}{\partial t}), n_H \right] = M \frac{\partial^2 u}{\partial t^2},$$

где в левой части стоит сила Магнуса, а "масса" вихря (на единицу длины)

$$M = \int_{-P_F}^{P_F} \frac{dk}{4\pi} q^2 \left( \frac{\partial \epsilon_{\nu}(k)}{\partial \nu} \right)^{-1} \sim Nm \xi_0^2.$$

Такая связь между током и смещением  $u$  приводит к существованию собственных колебаний решетки вихревых нитей с квадратичным законом дисперсии.

При  $|\omega| < \min(\partial \epsilon_{\nu}/\partial \nu)$  вещественная часть  $\text{Re } \sigma^{(0)}(\omega) = 0$  и диссипация отсутствует. Если же  $|\omega| > \min(\partial \epsilon_{\nu}/\partial \nu)$ , в подинтегральном выражении в (5) появляется полюсная особенность, вклад которой дает конечную вещественную часть  $\text{Re } \sigma^{(0)}(\omega)$ :

$$\text{Re } \sigma^{(0)}(\omega) = \frac{c e q_0^2}{B 4\pi} \frac{\partial \epsilon_{\nu}(k_0)}{\partial \nu} \left/ \left| \frac{\partial^2 \epsilon_{\nu}(k_0)}{\partial \nu \partial k} \right| \right.,$$

где  $k_0$  определяется из условия  $\omega = \partial \epsilon_{\nu}(k_0)/\partial \nu$ . Вблизи края "полосы поглощения",  $\omega = \min(\partial \epsilon_{\nu}/\partial \nu)$ , вторая производная  $\partial^2 \epsilon_{\nu}(k)/\partial \nu \partial k$  обращается в нуль, что приводит к корневой особенности в поглощении.

Для наглядности приведем выражение для  $\text{Re } \sigma^{(0)}(\omega)$  в модели [3], согласно которой  $|\Delta(\rho)|$  выходит на постоянное значение  $|\Delta_\infty|$  на расстояниях порядка  $\xi_1 = \xi_0 T/\Delta$ . В этом случае  $\partial\epsilon_\nu/\partial\nu = \frac{m|\Delta|^2}{q^2} \ln \frac{|\Delta|}{T}$  и

$$\text{Re } \sigma^{(0)}(\omega) = \frac{3\pi}{4} \frac{N_{\text{ec}}}{B} \frac{1}{\tilde{\omega}^{3/2}(\tilde{\omega}-1)^{1/2}} \Theta(\tilde{\omega}-1),$$

где

$$\tilde{\omega} = \omega 2E_F / |\Delta|^2 \ln \left( \frac{|\Delta|}{T} \right).$$

Институт теоретической физики  
им. Л.Д.Ландау  
Академии наук СССР

Поступила в редакцию  
16 февраля 1978 г.

### Литература

- [1] Н.Б.Копнин, В.Е.Кравцов. Письма в ЖЭТФ, **23**, 631, 1976.
- [2] С.Caroli, P.G. de Gennes, J.Matignon. Phys. Lett., **9**, 307, 1964.
- [3] L.Kramer, W.Pesch. Z. Phys., **269**, 59, 1974.